【SP-03】

Si(100) 구조상전이에 영향을 주는 요인

김태준, 오상훈, 강석태
연세대학교 물리학과

Si(100) 시료의 구조상전이를 일으키는 mechanism을 규명하기 위하여 RHEED(Reflection High-Energy Electron Diffraction)를 이용하여 온도(상온~800℃), 불순물(C_2H_4) 주입량의 변화에 따른 구조상전이를 관찰하였다. 또한, RHEED convert program을 이용해 변화된 구조를 분석하여 실험값과 비교 검토하였다.